

型名	社名	用途	構造	モ ド	最大定格					電 氣 的 特 性 (Ta=25°C)											
					V*** (V)	区分***	Vgs区 (V)	I* (A)	Pp/Pch (W)	I _{gss} (max) (A)	V _{GS} (V)	I _{DSS} (min) (A)	I _{DSS} (max) (A)	V _{DS} (V)	V _{GS(off)} (min) (V)	V _{GS(off)} (max) (V)	V _{DS} (V)	I _D (A)	G _m (min) (S)	G _m (typ) (S)	V _{DS} (V)
2SK648	松下	Ku-Band LN	GaAs/MES	N D	-6 GDO	-6 O	120m D	200m	-10 μ	-3	20m	120m	3	-3.5	3	100 μ	20m	50m	3	10m	
2SK649	松下	Ku-Band PA/OSC	GaAs/MES	N D	-6 GDO	-6 O	100m D	200m	-10 μ	-3	40m	80m	3	-3.5	3	100 μ	20m	40m	3	10m	
2SK650	松下	RF LN A	SB	N D	-6 GDO	-6 O	120m D	200m	-10 μ	-3	20m	120m	3	-0.3	-3.5	3	100 μ	20m	50m	3	10m
2SK651	松下	RF LN A	SB	N D	-6 GDO	-6 O	150m D	200m	-10 μ	-3	40m	150m	3	-1	-3.5	3	100 μ	20m	40m	3	10m
2SK652	松下	LF A, SW	J	N D	-55 GDO	-55 O	10m G	300m	-10n	-30	1m	20m	10	-5	10	10 μ	2.5m	7.5m	10	1DSS	
2SK653	松下	RF 広帯域 LN A	GaAs/MES	N D	5 DS	-4	50m D	200m	-80 μ	-3	15m	50m	3	-4	3	500 μ	40m	75m	3	20m	
2SK654, 654-Z	NEC	SW	MOS	N E	100 DSS	±15 S	±1 D	10	±100n	±15		10 μ	80	1	3	10	1m	0.5		10	0.5
2SK655	松下	SW	MOS	N E	50 DSS	8 O	100m D	200m	50n	8		10 μ	10	1.5	3.5	VGS	100 μ	20m	35m	5	20m
2SK656	松下	SW	MOS	N E	50 DS	8 O	100m D	200m	80 μ	8		10 μ	10	1.5	3.5	VGS	100 μ	20m	35m	5	20m
2SK657	松下	SW	MOS	N E	50 DSS	8 O	100m D	400m	50 μ	8		10 μ	10	1.5	3.5	VGS	100 μ	20m		5	20m
2SK658	松下	SW	MOS	N E	20 DS	8 O	100m D	400m	80 μ	8		10 μ	10	1.5	3.5	VGS	100 μ	20m		5	20m
2SK659	NEC	SW	MOS	N E	60 DSS	±20 S	±12 D	35	±100n	±20		10 μ	60	1	2.5	10	1m	5	10	10	6
2SK660	NEC	ECM Imp-C	J	N D	-20 GDO		10m G	100m			60 μ	500 μ	5	-1	5	1 μ	0.15m	1.2m	5	1DSS	
2SK661	NEC	C-MIC Imp-C	J	N D	-20 GDO		10m G	80m			60 μ	500 μ	5	-1	5	1 μ	0.15m	1.2m	5	1DSS	
2SK662	松下	LF A	J	N D	-30 GDO		10m G	150m	-100n	-30	0.5m	12m	10	-0.1	-1.5	10	10 μ	4m	12m	10	1DSS
2SK663	松下	LF A, SW	J	N D	-55 GDO	-55 O	10m G	150m	-10n	-30	1m	20m	10	-5	10	10 μ	2.5m	7.5m	10	5m	
2SK664	松下	SW	MOS	N E	50 DSS	8 O	100m D	150m	50n	8		10 μ	10	1.5	3.5	VGS	100 μ	20m		5	20m
2SK665	松下	SW	MOS	N E	20 DS	8 O	100m D	150m	80 μ	8		10 μ	10	1.5	3.5	VGS	100 μ	20m		5	20m
2SK666	日立	V/UHF A	GaAs/MES	N D	4 DS	-3	150m D	200m	-100 μ	-3	20m	80m	3				50m	85m	3	200m	
2SK667	松下	SW	MOS	N E	400 DSS	±20 S	8 D	80	1 μ	20		1m	320	1	5	25	1m	2.5	3.5	25	5
2SK668	日立	U/SHP LN A	GaAs/MES	N D	6 DS	0.5/-6	100m D	150m	10 μ	-6	20m	100m	5	-5	5	100 μ	15m	35m	5	20m	
2SK669	三洋	HS SW, A-SW, LPP	MOS	N E	50 DS	±12	100m D	200m	10n	10		1 μ	20	0.3	1.5	10	100 μ	25m	40m	10	50m
2SK671	ソニー	~X-Band RF/MIX	GaAs	N D	5.5 DSX	-4.5 O	120m D	300m	-10 μ	-4.5	35m	95m	3	-1	-3.5	3	100 μ	20m	28m	3	10m
2SK672	東芝	HS SW, DDC	MOS	N E	60 DSX	±20 S	10 D	40	±100n	±20		0.3m	60	1.5	3.5	10	1m	1.8	2.8	10	5
2SK673	東芝	HS SW, DDC	MOS	N E	60 DSX	±20 S	15 D	75	±100n	±20		0.3m	60	1.5	3.5	10	1m	3.5	5	10	8
2SK674	東芝	HS SW, DDC	MOS	N E	60 DSX	±20 S	25 D	100	±100n	±20		0.3m	60	1.5	3.5	10	1m	8	11	10	15
2SK676	ソニー	~X-Band RF/MIX	GaAs	N D	5 DSX	-3.5 O	70m D	340m	-100 μ	-3	10m	70m	2	-0.2	-3	2	500 μ	25m	40m	2	10m
2SK676H5	ソニー	MW LN A	GaAsHEMT	N D	5 DS	-3.5 O	70m D		-100 μ	-3	10m	70m	2	-0.2	-3	2	500 μ	25m	40m	2	10m
2SK677	ソニー	~X-Band RF/MIX	GaAs	N D	5 DSX	-3.5 O	100m D	340m	-150 μ	-3	15m	100m	2	-0.2	-3	2	500 μ	37m	60m	2	15m
2SK677H5	ソニー	MW LN A	GaAsHEMT	N D	5 DS	-3.5 O	100m D		-150 μ	-3	15m	100m	2	-0.2	-3	2	500 μ	37m	60m	2	15m

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)													コンプリ メンタリ	外 形	備 考	型 名
Cis (typ) (pF)	Crs (typ) (pF)	VGS (V)	VDS (V)	NF typ dB	NF max dB	f (Hz)	Rg (Ω)	Rps(ON) (max) (Ω)	VGS (V)	Ip (A)	その他特性	測定条件				
				1.8	2.3	12G						APG=8dBmin/10.5dBtyp	f=12GHz	210	DSGS	2SK648
				4.5		12G						APG=6dBtyp, MAG=5dBmin	f=12GHz	210	DSGS	2SK649
0.6		-6	3		2	4G								211	DSGS	2SK650
0.6		-6	3		4	4G								211	DSGS	2SK651
6.5	1.9	0	10	0.5		100	100k							213B	DGS	2SK652
				2.5	3.2	600M						PG1=9dB, PG2=13dBtyp	f1=600MHz, f2=50MHz	212	SD*G	2SK653
120	24	0	10					3	10	0.5	ton=12ns, toff=15nstyp	1D=0.5A, VDD=50V	276/Z:281	Z:ハイリットIC用	2SK654, 654-Z	
10	0.5	0	5					50	5	20m	ton=10ns, toff=20nstyp	VDD=5V, RD=200Ω	213A	SDG	2SK655	
9	1.1	0	10					50	5	20m	ton=toff=1μs	VDD=5V, RD=200Ω	213A	SDG	2SK656	
15max	1max	0	5					50	5	20m	ton=10ns, toff=20nstyp	VDD=5V, RD=200Ω	214	GDS	2SK657	
								50	5	20m	ton=toff=1μs	VDD=5V, RD=200Ω	214	GDS	2SK658	
1300	260	0	10					0.075	10	6	ton=90ns, toff=160nstyp	1D=6A, VDD=30V	274	GDS	2SK659	
6max		0	5								Coss=3pFmax	VDS=5V, VGS=0	104B	DGS	2SK660	
6max		0	5								Cos=3pFmax	VDS=5V, VGS=0	88	SDG	2SK661	
14	3.5	0	10								NV=60mVtyp	Gv=80dB, Rg=100kΩ, Flat	233	SDG	2SK662	
6.5	1.9	0	10	2.5		100	100k						233	SGD	2SK663	
15max	1max	0	5					50	5	20m	ton=10ns, toff=20nstyp	VDD=5V, RD=200Ω	233	SGD	2SK664	
								50	5	20m	ton=toff=1μsmax	VDD=5V, RD=200Ω	233	SGD	2SK665	
				2.7	3.5	900M					NF=2.8dB, PG=12.5dBtyp	f=50MHz	175B	GSDS	2SK666	
600		0	20					1.5	15	5			191	GDS, 代替2SK765	2SK667	
				2.5	3.5	3G					PG=8dBmin/10dBtyp	f=3GHz	199B	2SK457 chip	2SK668	
15	0.5	0	10					20typ	10	10m	Coss=6pFtyp	VGS=0, VDS=10V	157A	DGS	2SK669	
				3.5		12G					Ga=9dBtyp	f=12GHz	188	GSDS	2SK671	
370	85	0	10					0.2	10	5			183	GDS	2SK672	
650	150	0	10					0.11	10	8			183	GDS	2SK673	
1200	320	0	10					0.06	10	15			183	GDS	2SK674	
				1.4		12G					Ga=11dBtyp	f=12GHz	187	GSDS	2SK676	
				1.4		12G					Ga=9dBmin/11dBtyp	f=12GHz	177		2SK676H5	
				1.4		12G					Ga=11dBtyp	f=12GHz	187	GSDS	2SK677	
				1.4		12G					Ga=9dBmin/11dBtyp	f=12GHz	177		2SK677H5	